

### 掺杂技术对阻变存储器电学性能的改进

王艳<sup>①②</sup>, 刘琦<sup>②</sup>, 吕杭炳<sup>②</sup>, 龙世兵<sup>②</sup>, 王慰<sup>②</sup>, 李颖弢<sup>①②</sup>, 张森<sup>②</sup>, 连文泰<sup>②</sup>, 杨建红<sup>①</sup>, 刘明<sup>②\*</sup>

① 兰州大学物理科学与技术学院, 兰州 730000;

② 中国科学院微电子研究所纳米加工与新器件集成技术研究室, 北京 100029

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(0\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org